# 1 Attention 注意

每次渲染 index.html 之后,在 <head> 部分把原本的 stylesheet 部分换成以下代码

https://katex.org/docs/autorender.html

# 2 DFT Theory

latex test docs index

# 2.1 basic concepts 基本概念:如何计算

摘自 David S. Sholl, DensityfunctionalTheory

#### 2.1.1 Hohenberg-Kohn 1st Theorem:

The ground-state energy from Schroginger's equation is a unique functional of the electron density.

OR

ground state electron density uniquely determines all properties: energy/ wavefunction.

基态能量是电子密度分布函数(或者说,基态电子在空间中的密度分布)的泛函一个基态电子密度对应了唯一的能量、波函数。

问题: 泛函形式未知

# 2.1.2 Hohenberg-Kohn 2nd Theorem:

The electron density that minimizes the energy of the overall functional is the true electron density corresponding to the full solution of the schrodinger equation.

使这个泛函结果(能量)最低的电子密度是薛定谔方程的解->如果知道了泛函的形式,那么就可以计算出基态电子密度

# 2.1.3 n(r),或者基态电子密度

基态电子密度 
$$n_{(r)} = 2\Sigma \phi_i^*(r)\phi_i(r)$$
 更清楚一点

$$n_{(x,y,z)} = 2\phi_1^*(x,y,z)\phi_1(x,y,z) + 2\phi_2^*(x,y,z)\phi_2(x,y,z) + 2\phi_3^*(x,y,z)\phi_3(x,y,z) + \dots$$

缩成一维:

$$n_{(x)}=2\phi_1^*(x)\phi_1(x)+2\phi_2^*(x)\phi_2(x)+2\phi_3^*(x)\phi_3(x)+.....$$
,对所有电子是个期望值一样的东西

#### 2.1.4 泛函的具体形式 the energy functional=?

对于单个电子已知如下:

$$E[\phi_i(r)] = E_{known}[\phi_i(r)] + E_{unknown}[\phi_i(r)]$$

方括号是泛函的意思。类似于函数,把圆括号变成方括号 n(r) - E[] -

### ->E[n(r)]

 $E_{known}$ [] 是已知的能量泛函,包括电子动能,电子-核与电子-电子

 $E_{unknown}[]$  是未知的能量泛函:交换能

其中

$$E_{known}[\phi_i(r)] = \frac{-\hbar}{m} \sum \int \phi_i^*(r) \nabla^2 \phi_i(r) d^3r + \int V(r) n(r) d^3r + e^2/2 \int \int \frac{n(r)n(r')}{|r-r'|} d^3r d^3r' + E_{ion}$$

缩成一维,对于0号电子 $\phi_0$ 

$$E_{known}[\phi_0(x)]=\frac{-\hbar}{m}\sum\int\phi_0^*(x)\phi_i''(x)dx+\int V(x)n(x)dx+e^2/2\int\int\frac{n(x)n(x')}{|x-x'|}dxdx'+E_{ion}$$

(不太清楚为什么会有一个求和)

由于前述  $n_{(r)} = 2\Sigma \phi_i^*(r)\phi_i(r)$ 

所以虽然不知道是否合理,但是推导出来这个公式,即 phi 和 n(r) 有同样的泛函??

$$E[2\Sigma\phi_i^*(r)\phi_i(r)] = E_{known}[2\Sigma\phi_i^*(r)\phi_i(r)] + E_{unknown}[2\Sigma\phi_i^*(r)\phi_i(r)]$$
  
也就是说泛函的形式是  $E[] = E_{known}[] + E_{unknown}[]$ 

问题:解不出来电子密度 n(r) 因此需要 kohn sham 方程解 n(r)

#### 2.1.5 Kohn-Sham equation

Kohn-Sham equation 是用来找电子密度,即 n(r):

Kohn-Sham 方程是:

$$\left[\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r) + V_H(r) + V_{XC}(r)\right]\phi_i(r) = \epsilon_i\phi_i(r)$$
其中

V(r) 是薛定谔方程中已知的,是电子和所有原子核的相互作用

 $V_H(r)$  是 hartree potential,是 coulomb repulsion between "this electron" and "the total electron density",或者说电子 i 和整个电子密度 n(r) 之间的 coulomb repulsion

$$V_H(r) = e^2 \int \frac{n(r')}{|r-r'|} d^3r'$$
 理解为以 r 点的坐标向外积分?  $V_{XC}$  是未知的,虽然有  $V_{XC} = \frac{\delta E_{XC}(r)}{\delta n(r)}$  用人能看懂的方法重新写 对于 0 号电子,其具有能量  $\epsilon_0$ ,缩到一维,波函数满足  $\left[\frac{-\hbar^2}{2m}\phi_0''(x) + V(x) + e^2 \int \frac{n(x')}{|x-x'|} dx' + V_{XC}(x)\right]\phi_0(x) = \epsilon_0\phi_0(x)$ 

### 2.1.6 递归求解

1 初始电子密度

guess a initial trial electron density n(r)

- 2 解 kohn sham 方程,得到每一个电子的波函数 solve the kohn-sham equation with n(r), get the  $\phi(r)$
- 3 计算新的电子密度

通过 
$$n_{(r)} = 2\Sigma \phi_i^*(r)\phi_i(r)$$

4 调整电子密度递归运算

### 2.1.7 结论:

通过 Hohenberg-Kohn 定理和 Kohn-Sham 方程,距离比较精确地求解 薛定谔方程目前只差一个合适的  $E_{XC}$  泛函

# 2.2 寻找合适的 $E_{XC}$ 泛函

# 2.2.1 LDA 近似: 计算 Exc 的一种方式

如前文所讲 Exc 泛函是很难知道形式的。

Exc 只在一种情况下可以知道形式: 当 n(r)= 常数,即 uniform electron gas

 $V_{XC}(r) = V_{XC}^{electrongas}[n(r)]$ 

\* 防止混淆, 左边是函数  $V_{XC}()$ , 右边是泛函  $V_{XC}^{electrongas}[]$ 

使用 LDA 近似后,可以精确地解薛定谔方程,但是这个解不是真实解,因为薛定谔方程中的 Exc 是假的

#### 2.2.2 GGA

Use local electron density and the local gradient in the electron density calculation

局部电子密度,和局部电子密度的梯度

主流有: PW91 和 PBE

# 2.3 寻找合适的波函数-hartree fock

泛函在前文已经基本找好了,这里介绍找波函数的过程 当不考虑 Exc 时候,可以对 KohnSham 方程进行比较好的计算:

#### 2.3.1 单个电子与多电子的波函数

对于单个电子,其波函数是 localized 的,可以用类似于  $y=e^{-x^2}$  描述,没有周期性,且在远离 x=0 的地方 y 约为 0。但是对于晶体等多电子体系,应该使用周期性的波函数,比如  $y=sin^2(x)$ 

# 2.3.2 Hartree product

当总共只有一个电子时候,

h = E

会得到许多个解  $_j$  对于每个解  $_1$ ,2,3,.... (假设  $_1$  对应了最低能量) 对应的能量分别是  $E_1,E_2,E_3,....$ ,

其中  $E_1$  是能量最低的基态

对于多个电子体系来说

当忽略了电子-电子相互作用时

Hamiltonian:  $H = h_1 + h_2 + h_3 + ...$ 

 $h_i$  是第 i 个电子的动能和势能算符

可以得到  $\phi(x_1, x_2, ....x_n) = \prod_{ji}$  其中 j 代表了能级(像上面 j=1 是基态)

对于基态来讲  $\phi(x_1, x_2, ....x_n) =_{11} (x_1)_{12}(x_2)_{13}(x_3)...$ 

能量则是简单相加  $E = E_{11}, E_{12}, E_{13}, ....,$ 

以上方法求得的波函数由于忽略了电子-电子相互作用,所以存在以下问题:

然而, 当电子交换位置时候, 按照上式, 波函数的正负号没有变化

所以:引入 Slater determinant

双电子的 Slater determinant:

$$\phi(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \det \left\{ j(x_1)_j(x_2)_k(x_1)_k(x_2) \right\}$$

$$\phi(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [j(x_1)_k(x_2) - k(x_1)_j(x_2)]$$

这个波函数满足 pauli exclusiong principle: 不区分电子,当电子具有相同坐标时等于 0

#### 2.3.3 hartree fock calculation

hartree fock calculation 基于这个假设;原子核位置固定

Kohn sham 方程是  $\left[\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r) + V_H(r) + V_{XC}(r)\right]\phi_i(r) = \epsilon_i\phi_i(r)$  而对于 \*\* 单个 \*\* 电子,HF calculation 是:  $\left[\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r) + V_H(r)\right]\phi_i(x) =_j i(x)$  相比于 kohn sham 减少了一个 Exc 项

由前面 slater 行列式可以看到,如果想要描述一个 N 个电子体系,那么需要知道  $_1$  到  $_N$ 

对此,可以找到有限个(K 个)函数,即  $\phi_1(x)$  到  $\phi_K(x)$ ,使得这 K 个函数可以加权相加得到  $_1$  到  $_N$  这 K 个函数被称为 basis set 即:

$$j(x) = \sum_{i=1}^{K} \alpha_{j,i} \phi_i(x)$$
  
写的清楚一点,对第一个  $_1(x)$ :

 $a_{1}(x) = \alpha_{1,1}\phi_{1}(x) + \alpha_{1,2}\phi_{2}(x) + ... + \alpha_{1,K}\phi_{K}(x)$  现在已知  $\phi_{1}(x)$  到  $\phi_{K}(x)$ ,问题变成了找到  $\alpha_{j,i}$ 找到  $\alpha_{i,j}$  的方式:继续进行递归运算:

- 1, 猜测一组初始的  $\alpha_{i,i}$
- 2, 通过这个初始的  $\alpha_{j,i}$  计算出来一组  $\mathbf{n}(\mathbf{r})$
- 3, n(r) 代回  $j(x) = \sum_{i=1}^{K} \alpha_{j,i} \phi_i(x)$  方程, 求解  $\alpha_{j,i}$

通过这个递归运算,可以得到一个精确的能量值,这个能量值是 Hartree fock limit.

这个值虽然精确,但并不是实际的电子能量,因为没有考虑到 Exc,即 Hartree fock 方法实际上并没有解决电子-电子相互作用

#### 2.3.4 DFT 计算过程总结

结合上文 Kohn sham 方程计算, 完整的 DFT 计算过程如下:

- 1, 猜测一组初始的  $\alpha_{i,i}$
- 2, 通过这个初始的  $\alpha_{i,i}$  计算出来一组 n(r)
- 3, 通过这个 n(r) 解 kohn sham 方程(或者不精确的 Kohn sham 方程,这个时候计算的是 hartree fock limitx),得到每一个电子的波函数
  - 4, 用每一个电子波函数计算 n(r)

(通过  $n_{(r)} = 2\Sigma \phi_i^*(r)\phi_i(r)$ )

- 5, 将 n(r) 代回  $_{j}(x)=\sum_{i=1}^{K}\alpha_{j,i}\phi_{i}(x)$  方程, 求解  $\alpha_{j,i}$
- 6,得到的  $\alpha_{j,i}$  代回第二步

#### 2.3.5 Exc

Electron correlation energy = True system energy - Hartree fock limit. 即 Exc 就是实际的能量减去 Hartree fock limit

## 2.4 一些补充

参考书:Richard M. Martin  $_E lectronic structure: Basic theory and practical method$ 

## 2.5 物质的性质: property of matters

物质属性一般会取决于两个种类: 1、electronic ground state 基态电子 2、electronic excited state 激发态电子

原因是;原子核质量远大于电子,因此相对于电子来说可以基本看作静止这就是 Born-Oppenheimer approximation

电子最低能量态决定了原子核的结构 the lowest energy state of the electrons determines the spatial structure of nuclei:

# 2.6 bonding:

一般认为分为 5 类: closed shell system: 稀有气体 ionic metallic covalent hydrogen: 比较特殊, 因为氢原子是唯一没有 core electron 的(往上面的氦的 core electron 是 1s 的两个电子)

实际材料的 bonding 一般是这五种的结合

# 2.7 Hartree atomic units

 $\hbar = m_e = e = 4\pi/\epsilon_0 = 1$  定义以上单位为 1,用来简化计算

晶体学知识 crystallography 参考书:Richard M. Martin Electronicstructure:

Basic theory and practical method

A crystal can be completely specified by the types and positions of the nuclei in \*\*one repeat unit (primitive unit cell)\*\* and the rules that describe the \*\*repetition (translation)\*\*

primitive cell 有很多种, wigner seitz cell 是其中一种

Wigner Seitz cell: the most compact cell that is symmetric about the origin \*\* 注意 wigner seitz cell 是在 real space/实空间 \*\*

wigner seitz cell 在倒空间对应的是 \*\*first brillouin zone\*\*
fcc wignerseitzcell bcc firstbrillouinzone

#### 2.8 fourier transformation

 $! [Image] (/Fourier_series_and_transform.gif)! [Image] (/40cf849e55ed95732a60b52d4019d609_720w.) //zhuanlan.zhihu.com/p/19763358$ 

## 2.9 reciprocal sapce 倒易空间

考虑任何一个描述晶体性质的方程(比如说电子密度)

由于晶体的周期性,在实空间电子密度是周期性相同的,也就是说对于 电子密度 n(r + T(r')) = n(r) 其中 T 是任何的 translation 操作

# 2.9.1 一维理解

对于一个一维的,总共三个晶格的晶体,晶格常数为 a

那么电子密度 n(x) 必须满足:

$$n(x) = n(x+a) = n(x+2a)$$

当 0<x<a

因为 n(x) 有这样的周期性, 所以一定可以对其进行傅里叶变化

傅里叶变化是从 x 空间变为 q 空间 n(x) - > n(q)

对于这个长度为3的一维晶体,其中含有3个cell,那么晶格个数 N=3

从 x 空间到 q 空间的傅里叶变化是

$$n(q) = \frac{1}{\Omega_{crystal}} \int_{\Omega_{crystal}} dx n(x) exp(iq \cdot x)$$

代入条件

$$n(q) = \frac{1}{3a} \int_0^{3a} dx n(x) e^{(iq \cdot x)}$$

对于每一个晶格内部进行积分

$$n(q) = \frac{1}{3a} (\int_0^a dx n(x) e^{iq \cdot x} + \int_a^{2a} dx n(x) e^{iq \cdot x} + \int_{2a}^{3a} dx n(x) e^{iq \cdot x})$$

$$n(q) = \frac{1}{3a} \left( \int_0^a dx n(x) e^{iq \cdot x} + \int_0^a dx n(x+a) e^{iq \cdot (x+a)} + \int_0^a dx n(x+2a) e^{iq \cdot x + 2a} \right)$$

由于 n(x) 周期性 n(x)=n(x+a)=n(x+2a)

$$n(q) = \frac{1}{3a} (\int_0^a dx n(x) e^{iq \cdot x} + \int_0^a dx n(x) e^{iq \cdot (x+a)} + \int_0^a dx n(x) e^{iq \cdot x + 2a})$$

把 exp 拆开

$$n(q) = \frac{1}{3a} \left( \int_0^a dx n(x) e^{iq \cdot x} + \int_0^a dx n(x) e^{iq \cdot x} e^{iq \cdot a} + \int_0^a dx n(x) e^{iq \cdot x} e^{iq \cdot 2a} \right)$$

$$n(q) = \frac{1}{3a} (e^{iq \cdot 0a} + e^{iq \cdot a} + e^{iq \cdot 2a}) (\int_0^a dx n(x) e^{iq \cdot x})$$

从而得到三维大晶体的一般形式:

於則得到三维人間特別一般形式: 
$$f(q) = \frac{1}{\Omega_{crystal}} \sum_{0}^{N_x a1} \sum_{0}^{N_y a2} \sum_{0}^{N_z a3} e^{iq \cdot T(n1, n2, n3)} \int_{0}^{a1} \int_{0}^{a2} \int_{0}^{a3} dx dy dz f(x, y, z) e^{iq \cdot (x, y, z)} f(q) = \frac{1}{\Omega_{crystal}} \sum_{0}^{\infty} e^{iq \cdot T} \int_{0}^{\infty} dr f(r) e^{iq \cdot r}$$

T 是所有可能的平移(translation)操作

### 2.9.2 q 需要满足的条件

根据 Born-Von Karmen 条件, 傅里叶变化后的每一个 component 都必 须满足  $exp(iq \cdot Na) = 1$ 

为了满足  $exp(iq \cdot 3a) = 1$ ,则必须有:  $q \cdot a = 2\pi \frac{integer}{3}$  对于大晶体, $q \cdot a = 2\pi \frac{integer}{N}$  N 是一个很大的值,所以大晶体的 q 点是连续的

# 2.9.3 倒易矢量的定义

继续对于  $q \cdot a = 2\pi \frac{integer}{3}$ 尝试当 interger=1  $q \cdot a = \frac{2\pi}{3}$  $q = \frac{2\pi}{3a}$  $n(q) = \frac{1}{3a} (e^0 + e^{\frac{i2\pi}{3}} + e^{\frac{i4\pi}{3}}) (\int_0^a dx n(x) e^{iq \cdot x})$  $e^0 + e^{\frac{i2\pi}{3}} + e^{\frac{i4\pi}{3}} = 0$ 所以  $n(\frac{2\pi}{3a}) = 0$ 之后发现只有当  $q \cdot a = 2\pi \cdot integer$  时(而非  $q \cdot a = 2\pi \frac{integer}{3}$ ) n(q) 才有  $n(q) = \frac{1}{3a} (e^{2\pi} + e^{2\pi} + e^{2\pi}) \left( \int_0^a dx n(x) e^{2\pi} \right)$  $n(q) = \frac{1}{3a}(1+1+1)(\int_0^a dx n(x) * 1)$ 也就是说对任意 integer  $n(\frac{2\pi \cdot integer}{a}) = \frac{1}{a}(\int_0^a dx n(x))$ 可以说, $\mathbf{q}$  具有周期,周期是  $q = \frac{2\pi \cdot integer}{a}$ 从而定义单位倒易矢量  $b = \frac{2\pi}{a}$ 注意  $n(q) = n(q + \frac{2\pi}{a})$  这就是为什么只需要考虑第一布里渊区 使 n(r) 的 fourier component 非 0 的 q 的集合记为 G (倒易空间), G(m) = m \* b m 为任意正整数 m=0 为基态 \*\* 推广到三维大晶体 \*\* n(x + x', y + y', z + z') = n(x, y, z), 其中 x' y' z' 是整数倍的  $a_1 a_2 a_3$ a<sub>1</sub>a<sub>2</sub>a<sub>3</sub> 是三个晶格向量 傅里叶变化可以对所有有周期性性质的函数使用 因为 n(r) 有这样的周期性, 所以一定可以对其进行傅里叶变化 傅里叶变化是 n(r) - > n(q)

对于一个体积为  $\Omega$  的三维晶体,其中含有  $N_x \times N_y \times N_z = N_{cell}$  个 cell 的体系

根据 Born-Von Karmen 条件,傅里叶变化后的每一个 component 都要 满足  $exp(iq \cdot N_x a_1) = exp(iq \cdot N_y a_2) = exp(iq \cdot N_z a_3) = 1$ 

为了满足  $exp(iq\cdot N_xa_1)=exp(iq\cdot N_ya_2)=exp(iq\cdot N_za_3)=1$ ,则必须有:

$$q\cdot(a_1,a_2,a_3)=2\pirac{integer}{N_i}$$
 从  $r$  到  $q$  的傅里叶变化是 
$$f(q)=rac{1}{N_{cell}\Omega_{cell}}\sum e^{iq\cdot T}\int dr f(r)e^{iq\cdot r}$$
 通过计算, $q$  需要满足的条件从  $q\cdot(a_1,a_2,a_3)=2\pirac{integer}{N_i}$  变为

 $q \cdot (a_1, a_2, a_3) = 2\pi \cdot integer$ 对于满足条件的 q 的集合记为 G,  $G(m_1, m_2, m_3) = m_1b_1, m_2b_2, m_3b_3$ 其中  $m_1, m_2, m_3$  是任意整数, $b_1, b_2, b_3$  是  $a_1a_2a_3$  的倒向量

# 2.10 第一布里渊区

第一布里渊区是倒空间的 wigner-seitz cell 同样用上面的 3a 大小的一维晶体距离 注意倒空间是无限长的一维空间,倒空间两个相邻格点之间距离为 b=

第一布里渊区是  $-\frac{\pi}{a} < q < +\frac{\pi}{a}$  q=0 对应了基态

 $\frac{2\pi}{a}$ 

# 2.11 reference book 参考书

David S. Sholl,  $_Density functional Theory$  Kittel,  $_solid state physics$  Dehoff  $_Thermodynamics$